

化学結合から見たセラミックスの機能

1. セラミックスの素機能一粒界一

材料をどんどんミクロ化していくと、その構造面 からは原子配列にまでさかのぼることができる。原 子配列という見方からすると、異種材料を共通な基 盤から眺めることができ、確かに異種材料間に共通 なアプローチが見えてくる。しかし、それは主とし て構造や組成に関するものであり、あまりミクロ化 してしまうと、材料としての特性、すなわち機能が 失われてしまうことになる。

したがって、材料のもつマクロな機能をその発現 領域にまでさかのぼって追求すると、その機能を引 き起こすもとになっている最小単位の領域に到達す ると予想される。このような極限領域の機能を"素 機能"と定義することができる。素機能はミクロス コピックとマクロスコピックの中間、すなわち"メ ゾスコピック領域"に位置づけられる¹⁾。

セラミックスは、誘電体、圧電体、磁性体、ある いはイオンや電子の伝導体材料として幅広く利用さ れている。こういった機能性セラミックスの多くは 小さな結晶粒の集まりであるため、その特性は結晶 粒の性質と、粒子間境界一粒界一の性質の和になっ ている。素機能の視点からすると、粒界の特性・機 能はセラミックス全体の機能の素機能になっている といえる。

表1 粒界利用セラミックスの例

	材	料		組	成	デバイス
酸	化	亜	鉛	Z	nO	バリスタ、湿度センサ
チタ	ン酸	バリ	ウム	Ba'	TiO3	PTCRサーミスタ
チタン	ン酸スト	・ロンチ	ウム	Sr	ГiО₃	バリスタ、コンデンサ
マンフ	ガン亜針	出フェラ	イト	Mn-Z	n-Fe-O	磁気センサ
炭	化	珪	素	S	ыC	バリスタ、基板
超	任	ā	導	A-(Cu-O	粒界ジョセフソン素子
天白	12	4	夺手	A	Ju-O	松がノコビノノノポリ

第10研究グループ主任研究官 田 中 順 三

特に、センサやバリスタといった「粒界制御型セ ラミックス」では粒界の性質を積極的に利用してい て、さまざまな用途に使われている。表1に、現在 実用化されたり開発されつつある粒界利用材料の例 を示す。本稿では、素機能の視点に基づいた電子セ ラミックスの粒界研究について紹介する。

2. ナノ領域の化学結合状態

2.1.酸化還元粒界

セラミックスは、実用的には単体で用いられるこ とはむしろ少なく、いろいろな第2成分を添加して 用いられている。表1に示した材料の場合、多いも ので6~7種類の第2成分が添加されている。第2 成分を添加すると、粒界近傍に特異な組成分布が形 成され、粒界の特性が大きく変化する。この粒界(ナ ノ領域)の化学組成や結合状態をオージェ電子分光 法(μ AES)を用いて調べた。写真に測定装置を示 す。

図1にビスマスを添加したZnOバリスタの粒界の



 図1 酸化亜鉛バリスタの粒界の組成分布 μAESのディプスプロフィル(アルゴンイオンエッチ) から得られた結果。Bi偏析層の厚さは、イオンエッチ ングの速度から3nm程度と見積もられる。 組成分布を示す²⁾。添加物であるBiは粒界に高濃度 に偏析している。それに対して、主成分であるZnと Oは粒界の近くで減少している。この図の特徴は、 粒界の陽イオンの濃度(ZnとBiの和)が陰イオン(酸 素)濃度よりも大きい点である。したがって、図1 の結果から粒界は還元されていると考えられる。実 際、多くの粒界について酸素とビスマスの量をプ ロットすると、図2のようになり、ビスマスが増え



図2 酸化亜鉛粒界の酸素とビスマスの関係



図3 酸化ニッケルの粒界の組成分布

ると酸素が減少することがわかる。ビスマスを添加 していないZnOについては、粒界の陽イオンと陰イ オンの濃度は等しく、粒界は還元されていない。し たがって、ZnOの粒界はビスマスによって酸化還元 状態が変化すると考えられる。

一方、図3にリチウムを添加したNiOセラミック スの粒界の組成分布を示す²⁾。図のように,NiOでは 酸素が粒界で増加し、陽イオンの濃度(Niと偏析し たLiの和)より大きくなっている。したがって、NiO の粒界は、ZnOとは逆に酸化されていると考えられ る。

このように、ホスト (ZnO、NiO) とゲスト (添加 物: Bi_2O_3 、 Li_2O)の組み合わせによって粒界は還元 されたり、酸化されたりする。酸化物では、酸素の 欠損/過剰量は電気特性に大きく影響するから、粒 界の酸化還元状態を制御することが、粒界の素機能、 さらには材料全体の特性を制御するのに非常に重要 であるといえる。



図4 酸化亜鉛バリスタの粒界のオージェ電子スペ クトル

A:ビスマス [NVV]、B:酸素 [$KL_{2,3}L_{2,3}$]。2つの 図で同じ線種は測定した場所が同じ。Bのスペクトル はピーク値で規格化されている。

2.2. 粒界の分子軌道

ZnOの粒界で観測されたビスマスと酸素のオー ジェ電子スペクトルを図4に示す。図Aのように、 ビスマス偏析量は粒界によって変化し、それにとも なって酸素のスペクトル(KL_{2,3}L_{2,3}遷移)の形が変 化する(図4B)。特に、ショルダーとして観測される OII、OIIIピークがビスマス偏析量とともに成長する のが特徴になっている。KL_{2,3}L_{2,3}遷移は酸素の最外 殻軌道(L_{2,3}=2p軌道)が関係しているので、図Bの スペクトル変化は、粒界の酸素一金属間の結合状態 がビスマスの偏析によって変化することを意味して いる。

ZnOバリスタでは、非線形な電流電圧特性はBi₂ O₃を添加すると簡単に得られるが、Bi₂O₃がないと なかなか得られない。このことを考慮すると、図 4 から、バリスタ特性が粒界の結合状態に関係してい ることがわかる。

では、図4Bの酸素のスペクトル変化は具体的には 何を意味するのだろうか?その解答は、分子軌道法 によって得られる³⁰。ZnOの結晶格子(図5)に分子 軌道法(DV-Xa法)を適用すると、エネルギー準 位として図6が得られる。このエネルギー準位のう ちで、最高被占分子軌道(HOMO)は図7のように なっている。図のようにHOMOは部分的に反結合性 軌道を持っている。さらに、分子軌道計算の結果を 用いてオージェ電子スペクトルを計算すると図8の ようになる。図4Bと図8を比較すると、計算に用い



図 5 酸化亜鉛の結晶格子
 赤い球が酸素、青い球が亜鉛。緑色のクラスタイオン
 (OZn4⁶⁺) について分子軌道法を適用した。







図7 最高被占分子軌道

Zn1と酸素は反結合性軌道、Zn2と酸素は結合性軌道を 作っている。

たクラスターイオンが比較的単純であるにもかかわ らず、実験値と計算値はよく合っていることがわか る。

簡単のため、図 6 の分子軌道 ϕ (12e₁) と ϕ (15a₁) を ϕ (E_L) とし、 ϕ (19A₁) と ϕ (19e₁) を ϕ (E_U) とする。そうすると、図4Bの各ピークに関係してい



図8 計算で得られたオージェ電子スペクトル 酸素の部分状態密度のSelf-Convolutionから得られ る。各エネルギー準位の幅を3eVとした。

る分子軌道は、OIピークでは ϕ (E_L)だけ、OIIピー クでは ϕ (E_L)と ϕ (E₀)の両方、OIIピークでは ϕ (E₀)だけ、ということになる(図8参照)。したがっ て、OII、OIIピークが大きくなるということは、 ϕ (E₀)の酸素の部分状態密度が大きくなることに対 応している。つまり、粒界に偏析するビスマス量が 多くなると、HOMOに属している電子の空間分布が 変化する一具体的には、電子は酸素の方に多く存在 するようになり、逆に金属の方には少ししか存在し なくなる-ことを意味している。

フロンティア電子論によれば、有機化合物の熱反応はHOMOによって、また光反応はLUMO(最低空分子軌道)によって決まる。現在、粒界の反応にHOMO、LUMOがどのように効いているかは明かではない。しかし、ビスマスによって酸化亜鉛粒界のHOMOが変化し、それにともなって粒界準位が安定化されることを考えると、軌道の結合・反結合性、電子の分布が粒界の反応に大きく関与していることは想像に難くない。今後、分子・原子の立場から粒界の機能性を考えようとするとHOMOとかLUMO



写真 ナノ遷移領域解析装置

マイクロオージェ電子分光、X線光電子分光、トンネ ル分光法を複合化した装置。 μ AESは、超高真空(10^{-10} mbar)、高エネルギー分解能(0.01%)の性能を有す る。 といった電子軌道を考慮することがますます重要に なると予想される。

3. まとめ

粒の状態は複雑で、個々の粒界をみても構造や性 質が微妙に異なっている。したがって、系全体の性 質を理解するのに、マクロ領域の測定だけでも不充 分であるし、逆にミクロ領域の測定だけでも不充分 である。このため、粒界を一面から評価するのでは なく、いろいろな方法を用いて複合的に評価してい くことが必要とされる。実際、ここで述べたAES以 外にも、XPS、STS、EBIC、ICTS^{4,5)}などを用いた 研究が進みつつあり、セラミックスの機能性一素機 能に関する基礎データが集積されつつある。そのよ うな実験と理論的な研究の結果として、将来、セラ ミックスの材料設計が可能になることを期待したい。

引用文献

(初田) 肇、田中順三:機能性セラミックスの粒界とミクロ機能、応用物理、59[3]

301-309、1990

- J. TANAKA, H. HANEDA, S. HISHITA, et al.: Scanning Auger Microprobe Investigation of Grain Boundary Segregation in some Electroceramics, J. Phys. C, 51 (1990) 1055-1060
- S. TANAKA, C. AKITA, J. TANAKA, et al.: Chemical State Analysis of Grain Boundaries in ZnO Varistors by Auger Electron Spectroscopy, J. Solid State Chem.,投稿中
- 田中順三、田中 滋:セラミックス粒界の分光
 学的評価、センサー技術、11 (1991) 49
- 5) S. TANAKA, C. AKITA, J. TANAKA, et al.: Grain Boundary Interfacial States in BeO -doped SiC Ceramics-Photo Isothermal Capacitance Transient Spectroscopy, J. Appl. Phys.,印刷中

LiNbO₃の不定比と欠陥構造

1. はじめに

LiNbO₃(LN)は、強誘電体の1つで、その優れ た圧電特性、電気光学特性、非線形光学特性のため、 古くから研究が行なわれてきた。現在、表面弾性波 素子として広く実用化されており、また、光導波路 化した光学素子としても応用され、様々な素子の開 発研究が盛んに行なわれている。このように応用に 向け多くの研究が行なわれてきたにもかかわらず、 この化合物についての結晶化学的な研究は少なく、 Li/Nb比に関する不定比の機構、MgOなどの添加に よる特性向上の理由などについては、今だ不明な点 が多い。

図1はLiNbO₃の相図である¹⁾。Li₂O:Nb₂O₅= 50:50のいわゆる「化学量論(ストイキオメトリッ



ク)組成」からNb過剰側に固溶域が広がっており、 コングルエント(一致溶融)組成は、化学量論組成 と異なって少しNb成分過剰側によっていることが わかる。Nbが過剰になった場合、LiとNbでは+ 1、+5と価数が異なるため、空孔など何らかの欠陥 が生じるはずである。この欠陥は、高温で結晶中に 生じる欠陥や不純物によって生じる欠陥と異なり、 組成の関数として必然的にはいる欠陥であり、LN の場合、その量は他の欠陥に比べて圧倒的に多い。

LNの単結晶育成によく使われているチョクラル スキー法(回転引き上げ法)では、結晶の固化が進 むにつれ融液の組成が変化しないように、このコン グルエント組成を選んで育成が行なわれている。コ ングルエント組成LNには構造欠陥が相当量含まれ、



光学特性やデバイス作成において現われる様々な問 題と欠陥濃度が密接に関係している。これらの問題 を解決する上にも、欠陥の濃度を制御した結晶の育 成という課題に関連し、基本となる欠陥構造そのも のの解明がLNの理解に重要であった。

2. LNの構造と欠陥モデル

LNの構造は図2に示すとおりである。空間群は、 三方晶系R3cえ、酸素の積み重なりは、ABABA B・・・、陽イオン層の積み重なりは、ABCAB C・・・となっており、対称中心を持たない。陽イ オンが1種類の時は、 α ーアルミナ構造であり、陽イ オンが1層ごとに異なる時は、イルメナイト構造に なる。キューリー温度 (1200℃位) 以上でLNは、高 温型になるが、これは、Nbが2つの酸素層の真ん中 に移動しLiが酸素層の中に入った、対称中心をもつ 構造である。実はこの構造は、炭酸カルシウム構造 であり、ペロブスカイト構造が歪んだものであると 理解できる。つまりこれらは、ABO3の化学式を持つ ペロブスカイト類縁化合物として理解できる3)。

それはともかく、この基本構造に、何らかの欠陥 が入り、Nb過剰になるわけである。このLNの欠陥 構造については、これまでいくつかのモデルが提唱 されている。主なものは、

(1) [Li1-2x][Nb]O3-x「酸素欠陥モデル」

(2) $[Li1-5x\Box4xNbx][Nb]O3$ 「Liサイト空 孔モデル|

(3) $[Li1-5xNb5x][Nb1-4x\Box4x]$ 「Nbサイ ト空孔モデル|

の3つである(ここで□は空孔)。モデル(2)、(3)はあ わせて「陽イオン置換モデル」と呼ばれている。す でにNb過剰になるほど、密度が増大することが知ら れているが、Nb過剰量を変化させた単結晶を用いた



図3 LiNbO₃の実測密度とモデルの理論値 我々の測定でも確認できた。図3に各モデルについ ての予想値(実線)と、測定値(●)を示した。(1) の「酸素欠陥モデル」は不定比が大きくなるにつれ て密度が減少していくので、正しいモデルとはいえ ない。(2)、(3)の「陽イオン置換モデル」は逆に密度

が上昇するので、結局この2つのモデルのうちの一 方が正しいモデルであろうと思われる。両者とも、 単位格子あたりの分子量が全く同じなので、同じ組 成では同じ密度を示す。異なる点は、空孔がLiサイ トにあるのか、Nbサイトにあるのかのみの違いとな る。

「Liサイト空孔モデル」は、フランスのLernerら³⁾ によって提唱されたモデルで、「Nbサイト空孔モデ ル」は、ベル研 (アメリカ)のPetersonら⁴によって 提案され、同じくベル研のAbrahamsら⁵によって支 持されているモデルである。このベル研のモデルが 現在の定説となっている。しかし、無機材研におい て行なわれた拡散の実験によると、Nbサイトに空孔 のないモデルの方が実験事実を良く説明できること から、この定説に疑問が生じてきた。また最近のコ ンピューターシミュレーションによる結晶エネル ギー計算では、欠陥の相互作用を考えにいれない場 合、Lernerらの「Liサイト空孔モデル」の方がずっ とエネルギー的に安定であることが示されている。 3.LNの構造解析

我々は、これらの欠陥構造を明らかにし、ドーピ ングなどの効果、光損傷などについて理解を深める 目的のため研究を行なった。まず、化学量論比に近 い組成、コングルエント組成、コングルエント組成 よりもっとNb過剰な組成の(即ち不定比性の大きい 組成)LNの単結晶を育成し、光学的な研究に加え、 結晶構造の研究試料とした"。サンプルは、

- (1) 定比のもの:ST
- $Li_2O: Nb_2O_5 = 50.0: 50.0$
 - (2) コングルエント組成のもの:CG
- $Li_2O: Nb_2O_5 = 48.5: 51.5$
 - (3) 高不定比組成のもの:HN

 $Li_2O: Nb_2O_5 = 47.0: 53.0$

の3種類であった。構造解析は、単結晶X戦構造解 析と粉末中性子回折を併用して行なった。これらの 組成について、2つのモデルによる化学式とサイト

		理論式				
Li/(Li+Nb)	試料	「しサイト空孔モテル」	「Nb サイト空孔モデル」			
0.500		[Li _{1.0}][Nb _{1.0}]O ₃	[Li _{1.0}]]Nb _{1.0}]O ₃			
0.498	ST	[Li _{0,994} Nb _{0,0013} □ _{0.004}][Nb]O ₃	[Li _{0.994} Nb _{0.006}][Nb _{0.996} □ _{0.004}]O ₃			
0,485	CG	[Li _{0.951} Nb _{0.0098} D _{0.039}][Nb]O ₃	[Li0.951Nb0.049][Nb0.961D0.039]O3			
0.470	HN	[Li _{0.904} Nb _{0.0192} □ _{0.077}][Nb]O ₃	[Li0.964Nb0.096][Nb0.92300.077]O3			

表1 2つの「陽イオン置換モデル」の理論値

の占有率を表1に示している。

X線データーの解析の条件(消衰効果、非調和熱 振動、最小二乗法での重みなど)が、占有率に影響

表2 解析結果(化学式)とモデルの理論値

試料	化学式				
	理論式(Liサイト空孔モデル)	解析結果			
ST	[Li _{0.994} Nb _{0.0013}]NbO3	[Li _{0.996(3)} Nb _{0.005(2)}]Nb _{0.999(3)} O ₃			
CG	[Li _{0.951} Nb _{0.0098}]NbO ₃	[Li _{0.934(4)} Nb _{0.008(2)}]Nb _{0.984(4)} O ₃			
HN	[Li _{0.904} Nb _{0.0192}]NbO3	[Li _{0.891(4)} Nb _{0.013(2)}]Nb _{0.992(4)} O ₃			

を及ぼすため、化学量論組成に近い組成の試料ST で、LiとNbサイトの占有率が正しく求められるよう に解析条件の検討を行ない、同じ解析条件で、欠陥 を多く含む他の試料CG、HNの解析を行った。その 結果、不定比な試料CG、HNともNbサイトにほとん ど空孔が見いだされず、また、Nb成分が増加しても 占有率は変化しないことがわかった。得られた化学 式は、表2に示した。最終的なwR値は、1%程度ま でさがった。これらの結果は、定説とは異なり、Nb サイトに空孔のないモデルすなわち「Liサイト空孔 モデル」を支持している。

X線の場合、電子密度との相互作用であるから、 結晶中のイオンの価数が結果に影響を及ぼすと考え られる。しかしこれを求めることはできない。一方、 原子核と直接相互作用する中性子回折は電子数、価 数とは無関係であるし、中性子に対するLiとNbの、 質量吸収係数の差はX線ほどではないため、Liに関 する情報もX線に比べ確度の高いものが得られると いえる。また、粉末法では、消衰効果がほとんどな いという利点もあり、情報量が少ないとはいえX線 の解析結果を確認するのに充分有効と考えられる。 この観点から、第4研究グループの泉博士に粉末中 性子線回折のリートベルト解析をお願いした。それ ぞれの試料について、「陽イオン置換モデル」の2つ のモデルを仮定しリートベルト解析を行なった。い ずれの場合も、Nbサイトに空孔のない「Liサイト空 孔モデル | の方が有意に低いR値を示した。また、 ベル研のモデルでは、Liサイトの温度因子が負にな るなど異常な結果となり、X線解析の結果を裏付け た。

このようにして、これまで、定説として信じられ ていたモデルに代わり、新たに「Liサイト空孔モデ ル」をLNの欠陥モデルとして提案することができ

外部発表

投稿

た8)。

今回、より精度の高い結晶構造解析を目的とし、 また物性と組成の関係を調べるために任意のLi/Nb 比をもったLN固溶体単結晶を合成したわけである が、このようなやり方は、合成、構造、物性の3つ を組みあわせた、まさに無機材研的なやり方と言え るかもしれない。我々が明らかにしてきた欠陥モデ ルと従来のモデルでは、空孔のサイトが異なるだけ ではなく、Liサイトを占める過剰なNbイオンの濃度 が著しく異なる。このことは、第三成分の添加によ る空孔の数の変化などを理解する上で、どちらのモ デルをとるかで大きな違いとなって現われる。今回 の欠陥モデルを提唱することにより、欠陥と物性と の関係などに関し、より正しい理解ができると期待 している。

尚、本研究は科学技術庁振興調整費「レアメタル の高純度化による新機能創製のための基盤技術に関 する研究」の一環として遂行されてきたことを付記 しておく。

- 4. 参考文献
- J.R. Carruthers, G.E. Peterson, M. Grasso, and P.M. Bridenbaugh, J. Appl. Phys, 42, 1846 (1971)
- 2)近 桂一郎、固体物理16, 199 (1981).
- P. Lerner, C. Legras, and J.P. Dumas, J. Cryst. Growth, 3/4, 231 (1968).
- 3) G.E. Peterson, and A. Carnevale, *J. Chem.Phys.* 56, 4848 (1972).
- S.C. Abrahams and P. Marsh, *Acta Crystallogr*. Sect. B42, 61 (1986).
- 6) H. Donnerberg, S.M. Tomlinson, C.R.A. Catlow and O.F. Schirmer, *Phys. Rev. B*, 40, 11909 (1989).
- K. Kitamura, T. Hayashi, H. Haneda, N. Iyi, and S. Kimura, to be published in *J*. *Crystala Growth*.
- N. Iyi, K. Kitamura, F. Izumi, J.K. Yamamoto, H. Hayashi, H. Asano and S. Kimura, to be published in *J. Solid State Chemistry*.

登録番号	題			Ê 表=	者	掲	載誌	等
2863	Solvent Extraction line Earth Metal I fluoroacetone and Oxide in Carbon Te	Separation of Alka- ons with Thenoylri- Trioctylphosphine trachloride	小松 藤木 道上	優・矢島 良規・佐々 勇一	祥行 木高義	Solvent Ion Excl 9, 3, 47	Extrac hange 1~479,	tion and 1991

2864	Hydrothermal synthesis of beidellite from aluminosilicate glass by varying	山田 吉岡	裕久・中沢 克昭	弘基	Mineralogical Journal 15., 7, 300, 1991
2865	water/solid fatto 極微小領域の分析	板東	義雄		セラミックス 26 10 1123~1124 1991
2866	セラミックス粒界の分光学的評価	田中	順三·田中	滋	20, 10, 1123, 1124, 1351センサ技術11 12 49 1991
2867	Preparation of silicon oxyniteride glass fibers by ammonolysis of silica gels	関根 三友	正裕・片山 護	真吾	Journal of Non-Crystal- line Solids 134 119 1191
2868	Galvanomagnetic Properties of $Ta_{\tt s}S_{\tt 2},$ $Ta_{\tt s}S$ and $Ta_{\tt s}S$	野崎 竹川	浩司・和田 俊二	弘昭	Journal of Physical Soci- ety of Japan 60 10, 3510 1991
2869	マンガン亜鉛フェライトセラミックス粒界 のオージェ電子分光	秋田 藤本	千芳・田中 正文・羽田	順三 肇	分析化学 40.11.867.1991
2870	水酸アパタイトを用いたトリエチレンガス の酸化的接触分解	西川	治光・門間	英毅	日本化学会誌 11,1562,1991
2871	Scanning tunneling microscopy of monolayer graphite epitaxially grown on a TiC(111) surface	井藤 一ノ潟 大島	浩志・市川 順 威・相沢 忠平	竹男 俊	Surface Science Letters 254, L437, 1991
2872	高圧下における水溶液からの結晶成長	竹村	謙一・沢田	勉	固体物理 25, 3, 156~162, 1990
2873	A diamond anvil cell for advanced micro- scopic observations and its application to the study of crystal growth under pres-	竹村 沢田	謙一・下村 勉	理	Review of Scientific Instruments 60, 12, 3783, 1989
2874	Atomic Crack Tips in Cavalent Crystals	田中 三友	英彦・板東 護・猪股	義雄 吉三	Proceedings 1st, Sympo- sium of Advanced Mate- rials Science and Engi-
2875	Smectites in the montmorillonite-beidel-	山田	裕久・中沢	弘基	Clay Minerals
2876	Crystal Structure and T_c of $YBa_2Cu_3O_y$ (y > 7)	太田	元哈・藤田 正恒・岡井	山政	26, 5, 559~509, 1991 Japanese Journal of Ap- pled Physics 30, 8, L1378~L1380,
2877	High Voltage Electron Microscopy of	高橋	裕・田中	英彦	J.Electron Microsc.
2878	Pressure-induced Structural Phase Tran- sition of Indium	须 何 村 藤久	唯加 、 徹 元 ・ 下村 裕司	理	40, 5, 325 330, 1991 Photon Factory Activity Report 1991 91-091 1991
2879	Search for Core Ionization in Cesium Under Ultra-High Pressure	竹村 藤久	謙一・下村 裕司	理	Photon Factory Activity Report 1991 91-096, 1991
2880	TMAによるセラミックスの初期焼結機構 の解析	池上	隆康		熱測定 18.4.247~249.1991
2881	6H→3C Transformation in SiC-TiN Powder Mixture at High Temperature	田中 提	英彦・竹川 正幸	俊二	J. Ceram. Soc. Japan Int. Edition 99, 363, 1991
2883	High Voltage Electron Microscopy of Crack Tip Dislocations in MgO	板東 高橋	義雄・須賀 裕・田中	唯和 英彦	Journal of Electron Microscopy 40, 5, 325~336, 1991
2884	High-Resolution Holography Observation of $H\text{-}Nb_2O_5$	板東 川崎 Qing	義雄・松田 猛・外村 Xin Ru	強 彰	Japanese Journal of Applied Physics 30, 10, L1830~1832, 1991
2835	Shock Wave Equation of State of Mus- covite	関根 A.M T I	利守 . Rubin Abrens		Jour. Geophys. Res 96, B12 19, 675~19, 680, 1991
2886	レドックスインターカレーション・デイン ターカレーションを活用した物質合成の展 闘	佐々7	 「高義		化学と工業 44,11,1967,1991
2887	Bonding Between Lanthanum Transition Metal Perovskite and Zirconium Oxide	羽田 渡酒	肇・白寄 明男・高鴨 武史・寺田	信一 雅則 裕美	Proceedings of the Sec- ond Japan International SAMPE Symposium 264 1991
2888	バリウムを含む新規三元系硫化物	佐伯	昌宣		204, 1391 セラミックスジャパン 26, 12, 1300~1304, 1991

2889	Deposition of Diamond Crystal at Sub- strate Temperature Lower Than 500°C	加茂 安藤	睦和・板東 完治 寿浩・佐藤洋一郎	Proceeding of the Sec- ond International Con- ference New Diamond Science and Technology
2900	SIMS Analysis of Epitaxially Grown CVD Diamond	加茂 安藤	睦和・坂本 尚義 寿浩・佐藤洋一郎	467, 1991 Proceeding of the Sec- ond International Con- ference, New Diamond Science and Technology 627, 1991
2901	ジルコニヤ結晶内の酸素原子の超高分解能	堀内	繁雄・松井 良夫	日本結晶学会誌
2902	電士頭傾魏による直接観祭 ニューキャッスル大学	三友	護	33, 6, 346, 1991 セラミックス
2903	「BNのバルク成長」 * 高圧法について	三島	修	27,1,30,1992 高輝度青色発光のための 電子材料技術
2904	Visual Observations of the Amorphous -Amorphous Transition in H ₂ O Under	三島 青木	修・竹村 謙一 勝敏	109~115, Science 254, 406~408, 1991
2905	Porosity Dependence of Young's Modulus in Metal Boride Particulate Silicon Carbide	田中	英彦・長谷川安利	Proceeding of Interna- tional Symposium on the Science of Engineering Ceramies
2906	新物質の探索研究	君塚	昇	研究技術計画
2907	Toughening of Silicon Nitride Ceramics by Microstructure Control	三友	護	b, 1, $37 \sim 42$, 1991 Proc. of the 1st Interna- tional Symposium on the Science of Engineering Ceramics $101 \sim 107$, 1991

× E

運営会議

5月25日、第122回運営会議が

- 1) 平成5年度重要施策について
- 2)長期計画委員会中期報告「活性化方策について|

3)機能性スーパーダイヤモンド研究について

の議題で開催された。

海外出張

第8研究グループ主任研究官加茂睦和は、「ニュー ダイヤモンド科学技術ワークショップに参加・講演 及びダイヤモンド研究に関する意見交換」のため平 成4年4月24日から平成4年5月3日までスイス連

邦、ドイツ連邦共和国及び連合王国へ出張した。 第4研究グループ総合研究官堀内繁雄は、「原子解 像電子顕微鏡及び関連装置を用いての材料研究にお ける科学技術的機会を評価するためのパネルワーク ショップに出席|のため平成4年5月24日から平成 4年5月30日までアメリカ合衆国へ出張した。 外国人の来所

1. 来訪日時 平成4年5月27日 来訪者名 鐘 達雄 他12名 台湾 工業技術交流訪問団

HI.	ritte
ĽX.	貝

表彰者名	表彰名または 表 彰 機 関	表彰の内容	表彰年月日
雪野 健	科学技術庁長官賞	走作型X線解析顕微鏡の開発	1992年5月19日
室町英治	11	高温超電導体の解析	1)
北村健二	11	二重るつぼ法による大型単結晶の合成	11

発行日 平成4年7月1日 第134号 編集·発行 科学技術庁 無機材質研究所 NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN INORGANIC MATERIALS 〒305 茨城県つくば市並木1丁目1番 電話 0298-51-3351